# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11–224839 (43)Date of publication of application: 17.08.1999

(51)Int.Cl. H01L 21/027 603F 7/20 603F 7/20 603F 7/20 H01L 21/304

 (21)Application number : 10-023278
 (71)Applicant : CANON INC

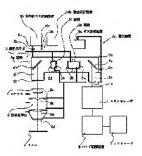
 (22)Date of filing :
 04.02.1998
 (72)Inventor : HASE TOMOHARU YAMANE YUKIO

# (54) EXPOSURE SYSTEM, MANUFACTURE OF DEVICE, AND CLEANING METHOD OF OPTICAL DEVICE OF EXPOSURE SYSTEM

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To more easily and effectively prevent an optical device from being contaminated by organic molecules by a method wherein inert gas is supplied to an optical system closed space, and oxygen or clean air is fed.

SOLUTION: Nitrogen gas as inert gas is supplied to the inner space 2j of a case 2g of an illuminating optical system 2, the inner spaces of lens tubes 2h and 2i, and spaces partitioned by lenses in a lens tube of a projection lens 5 respectively. Therefore, an inert gas feed device 8a is provided. The inert gas feed device 8a is connected to the above spaces through an inert gas feed line 8b and a solenoid valve 8c (open-close valve) provided to the line 8b respectively. An oxygen feed line 10b is joined to the inert gas feed line 8b, and an oxygen feed device 10a is connected to the oxygen feed line 10b through the intermediary of a solenoid valve 10c (open-close valve) provided to the oxygen feed line 10b. Oxygen-containing clean air may be mixed in place of pure oxygen.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 27.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than withdrawal

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

21.07.2006

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-224839

(43)公開日 平成11年(1999)8月17日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FΙ	
HO1L	21/027		H 0 1 L 21/30	515D
G03F	7/20	503	G03F 7/20	503
		505		505
		5 2 1		5 2 1
H01L	21/304	6 4 5	H 0 1 L 21/304	6 4 5 Z
			審査請求 未請求 請求項の数18 (	OL (全 6 頁) 最終頁に続く

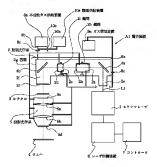
		審査請求 未請求 請求引	自の数18 OL (全 6 頁) 最終頁に続く	
(21)出願番号	特顧平10-23278	(71)出顧人	(71)出願人 000001007 キヤノン株式会社	
(22) 出順日	平成10年(1998) 2月4日 東京都大田区下丸子3丁目30番2号			
		(72)発明者	長谷 友晴	
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ	
			ン株式会社内	
		(72)発明者	山根 幸男	
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ	
			ン株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 丸島 儀一	

(54) 【発明の名称】 露光装置とデパイス製造方法、ならびに該露光装置の光学素子クリーニング方法

(57)【要約】

【課題】 有機分子による光学素子の汚染問題を簡単かつ効果的に解決した露光装置を提供すること。

【解決手段】 エキシマレーザ等の業外練あるいはX線 の魔光ビームを基板に照射して露光を行なう魔光装置の 光学素子をクリーニングする方法であって、該光学業子 が置かれた空間に微量の酸素を含む不活性ガスを供給し 、該露光生した本を照射することで該空間別にてオゾン 生成させ、該発生したオゾンと該露光ビームの照射によ る光化学反応によって該光学部村に付着した有機化合物 を除去する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 鑑光ピームを生成する大瀬と、該郷光ピームを基底に照射して環境を行なうための間空間を有す 充光学系を備えた鄭光を握い払いて、該光学系の間空間 に不活性ガスを供給する手段と、酸素もしくはクリーン エアを供給する手段を設け、該閉空間に不活性ガスと酸 素を供給し得るようにしたことを設けたことをことを特 後とする原米装置。

【請求項2】 前記光学系は照明光学系もしくは投影光 学系であることを特徴とする請求項1 記載の露光装置。 【請求項3】 前記光源は紫外線もしくはX線を発生す る光源であることを特徴とする請求項1 記載の露光装 398

【請求項4】 前記光源はArFエキシマレーザ光源で あることを特徴とする請求項3記載の露光装置。

【請求項5】 前記不活性ガスは窒素、ヘリウム、又は ネオンであることを特徴とする請求項1記載の露光装 置。

【請求項6】 不活性ガスに酸素もしくはクリーンエア を混入させる手段を設けたことを特徴とする請求項1記 歳の露光装置。

【請求項 7】 前定開空間に不活性ガスを供給するため の供給ラインを有し、該供給ラインを分岐したラインか ら酸素又はクリーシエアを導入して混入させることを特 後とする請求項 6 記載の應光装置。

【請求項8】 前記閉空間内のガスを排気する手段を有することを特徴とする請求項1記載の露光装置。

【請求項9】 前記排気したガス中の残留オゾンを酸素 に変換して再利用する手段を設けたことを特徴とする請 求項8記載の露光装置。

【請求項10】 前記簿光ピーム波長を変化させる手段 を設けたことを特徴とする請求項1万至9のいずれか記 歳の露光装置。

【請求項11】 前記酸素を供給したときには露光ピームをより酸素吸収率の高い波長帯城に変化させることを 特徴とする詰求項10記載の露光装置。

【請求項12】 前記酸素を供給したときには露光ピーム波長をより頻波長側に切り替えることを特徴とする請求項10記載の露光装置。

【請求項13】 請求項1乃至12のいずれか記載の露 光装置を用意する工程と、該露光装置を用いて露光する 工程を有することを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項14】 露光前に基板にレジスト途布する工程 と、露光後に現像する工程をさらに有することを特徴と する請求項13記載のデバイス製造方法。

【請求項15】 紫外線又はX線の露光ビームを基板に 照射して腐光を行なう意光装置の光学索子をクリーニン グする方法であって、意光学系子が置かれた空間に微量 の酸素を含む不活性ガスを供給して、該露光ビームを服 射することで該空間内にてオゾン生成させ、該生成した オゾンと該露光ビームの照射による光化学反応によって 該光学部材に付着した有機化合物を除去することを特徴 とする露光装置の光学素子クリーニング方法。

【請求項16】 基板に離光を行なう時と光学素子をクリーニングする時とで露光ピーム波長を変化させることを特徴とする請求項15記載の方法。

【請求項17】 離光ビームを発生する光源の駆動を制 御する、あるいは政長変換手段を光路中に挿入すること で、 離光ビーム波長を変化させることを特徴とする請求 項16記載の方法。

【請求項18】 除去された有機化合物を前記空間から 排出することを特徴とする請求項15記載の方法。

【発明の詳細な説明】

#### [0.001]

【発明の馬する技術分野】本発明はエキシマレーザ等の 紫外線あるいは X線などの無波片電磁波を露光ビームと して用いる露光装置に関する。さらには該露光装置を用 いたデバイス製造方法や該露光装置の光学素子クリーニ ング方法に関する。

#### [0002]

【0003】光期から放射された露光ビームは、レチクルを照明する原明光学系及びレチクルに形成された微細 パターンを療送核圧に結構を含せる後光光学表で飲む レンス)により前記微細パターンを感光基板上に露光転写している。上記のような従来の露光装置において、力を レている。上記のような従来の露光装置において、次の手 が要求されるようになり、これに伴って露光ビームと してはますますれイパワールものが要求されると同時 に 露光ビールの安長帯板の世長化が進んでいる。

【0004】しかし、1線(数長え=365m 割 ある いはさらに短波長の魔光ビームを用いた場合は、短波長 化により魔光ビームが空気中の不純物を修業と光化学反 応させることが知られており、かかる反応による生成物 (曇り物質)が光学系の光学楽子(レンズやミラー)に 付着し、不適明な「曇り」が生じるという不都合があっ か

【0005】この曇り物質としては、例えば重成能80g が光のエネルギを吸収し版起状態となると、空気中の酸 素と反応 (機化) することによって生じる硫酸テンキニ ウム (NH、) 280,が代表的に挙げられる。この硫酸アン モニウムは白色を俗びており、レンズやミラー等の光学 が材み表版に付着すると前記「曇り」状態となる。そし て、魔光ピームは硫酸アンモニウムで散乱や吸収される 結果、前記光学系の透過率が減少するため、感光基板に 到途するまでの光量(透過率)低下が大きくなってスル ープットの低下を招くおそれがある。

【0006】特に、ArFエキシマレーザ(193nm)やX線のようにより短い波長領域では、露光ピームがより強い光化学反応を生起させるため上述の問題は顕著となる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】これに対して、特問平 6-216000号公報に開示される装置では、密閉構造の筐体にレンズ等のガラス部材の配置された鏡筒を配置して、筐体の内部に不活性ガスを充填することで上記問題の解決にあたっている。

【0008】ところが、不存性ガスを用いた上記例で も、照明光学系の値体や鏡筒の内部の光学素子は右機分 子によって汚染されていることが判明した。これらの分 子は、照明光学系を構成する各部品を構成する部品の製 作・加工工程で使用された場品等が部品上と発留してい たもの、あるいは値体や鏡筒に使用されている接着剤の 一部が蒸発して発生したものと考えられる。

【0009】さらに、製造上の状況においても、周囲の 空気が削えば基板とフオトレジストとの間の接着剤層か ら発生する有機分子によって汚染されており、これらの 分子が個体や鏡筒内に侵入する恐れがある。たとえ有機 等のために分解して光学素子上に沈吸し、これらの影 響のために分解して光学素子上に沈吸し、これらのまし に炭素製または炭素を含んだ腕を形成することになる。

【0010】これを解決するため、特得平7-2095 69号公報に開示される装置では、投影光学系に不活性 ガスを供給する際に、この不活性ガスに微量のオゾンを 混入させ、オゾンを含む不活性ガスを光学系に供給して いる。オゾンを含むガス中に初いて光学系下に露光ピー ムが照射されるので、いわゆるオゾン洗件効果により光 学業子表前の有機粒子の分解および分辨生皮物の堆積物 の生成が防止されるよりたなっている。

【0011】しかしながら酸羧酸では、火蝎ランプを具 えるオソン生成器を不活性ガス供給ラインの途中に設け て、該オソン生成器で予めカインを発生させてから、オ ソンをレンズホルダ内に供給している。そのため露光光 家と共にオソン発生用光密の2つが必要で装値が複雑化 するという問題点だかりでなく、以下のような危険性も 有している。すなわち、オソンは物体を劣化させる性質 を持っているため、オソン発生器自体がオソンの影響で 劣化し易いという問題点を有し、劣化したオソン多生器 から有害なオソンが外部に満れ出す危険性を付らんでいる

【0012】本発明は上記従来例の装置が有する課題を 解決すべくなされたもので、有機分子による光学素子の 汚染問題の解決、それもより簡単かつ効果的に解決した 露光装置を提供することを目的とする。さらには該露光 装置を用いたデバイス製造方法や該露光装置の光学案子 クリーニング方法を提供することを目的とする。 【0013】

【課題を解決するための手動】上記課題を解決する本巻 即の震光装置の好ましい形態は、紫外線では終め霧光 ピームを在成する光頭と、誘躍光ピームを基板に照射し て霧光を行なうための閉空間を有する光学系を備えた霧 光装版において、該光学系の空間に不活性スを供給 する手段と、酸素もしくはクリーンエアを供給する手段

する手段と、酸素もしくはクリーンエアを供給する手段 を設け、該閉空間に不活性ガスと酸素を供給し得るよう にしたことを設けたことをことを特徴とするものであ る。

【0014】また本発明のデバイス製造方法は、上記露 光装置を用意する工程と、該露光装置を用いて露光する 工程を有することを特徴とするものである。

【0015】また本発明のさらに別の形態は、紫外線及 はX線の腐光ビームを基板に脱射して霧光を行なう露光 装置の光空楽子をクリーニングする方法であって、該光 学案子が置かれた空間に微量の酸素を含む不活性ガスを 供給して、該露光ビームを照射することで窓空間内にて オソン生成させ、該生成したオゾンと該第光ビームの照 射による光化学反応によって該光空部村に付着した有機 化合物を除去することを特徴とするものである。

#### [0016]

【発明の実施の形態】本発明の具体的な実施例を図面に 基づいて説明する。本例の魔光装置は一般にステッパあ るいはスキャナと呼ばれる縮小投影型の半導体魔光装置 である。

【0017】露光装置本体A1は大まかに、光源1(A r Fエキシマレーザ光源) と、光源1から発せられた照 明光であるレーザ光L1を所定の形状の光東に成形する 照明光学系である光源レンズ系2と、該光源レンズ系2 によって所定の形状に成形されたレーザ光L1をレチク ル3を経て基板であるウエハ4に結像させる投影光学系 である投影レンズ系5を備える。光源1はそのレーザ出 力を制御するレーザ制御装置6を有し、レーザ制御装置 6は制御手段であるコントローラ7によって制御され る。後述するように、レーザ制御装置6は発振レーザー 波長帯域を変化させることができるようになっている。 【0018】なお、本例では光源として紫外線を発生す ろArFエキシマレーザ光源を用いたが、KrFエキシ マレーザ光源、あるいはさらに波長の短いX線(軟X線 や真空紫外線を総称してX線と呼ぶ)を発生するレーザ プラズマ放射源やシンクロトロン放射源などのX線源で あっても良い。

 引き回すためのミラー4a、4bが収容されている。照 明光学系の容器2gは、光瀬しに対向する入射口に脱着 可能な窓2eが、レチクル3に対向する出入口に窓2f が設けられている。

【0020】また、投影光学系5はレチクル上のバターンをウエハ上に縮小投影するための複数のレンズ5 a、5 bがレンズ鏡筒に内蔵され、レンズ鏡筒のレチクルと対向する面及びウエハと対向する面にそれぞれ懲5 c、5 dが設けられている。

【0021】ここで照明光学系2の容器2gの内部空間 2j、 統簡2h、2iの内部空間、及び投影レンズ5の レンズ機関りのレンズにより区切られた空間、のそれぞ れには、不活性ガスである窒素ガス (ヘリウムやネオン であっても良い) が供給される。このために不活性ガス 供給装置8aが設けられている。不活性ガス供給装置8 aは不居性ガス給気ライン8bとこの途中に設けられた 期間所である電磁弁8cを力して上記を空間に接続されている。また、不活性ガス供給ライン8bの途中には、 酸素供給ライン10bが9転接続され、途中に設けられた に関係すである電磁弁10を介して機実体を装置10 aが接続される。これにより供給する不活性ガスに微量 の酸素を混入することが可能となっている。なお、純粋 を機能の付いるで表現を対している。なお、記述

【0022】 さらに、不活性ガスが供給される上記の各空間からガスを排出するために、ガス排気装置9aが設けられ、各空間からガス排気ライン9b及びライン途中に設けられた開閉弁である電磁弁9cを介してガス排気装置9aに接続されている。

ようにしてもよい。

【0023】 なお、ガス棒気手段によって同収されたガ ス中には微量の残留オゾンが含まれるが、これを酸素に 再定機力る変極器をガス棒な装置9 a に設けて、再変換 された酸素をフィルタを介して不純物を除去した後、酸 素供給装置10 a に透流させて再利用するようにしても βい、

【0024】これらの不派性ガス供給手段ならびにガス 地気手段のライン途中に設けられた電磁弁8c、9c は、コントローラアに予め設定されたプログラムによっ て制御され、各空間は通常の装置使用時(露光時)や待 機時に不配性ガスが充質された状態を維持するようになっている。

【0025] 具体的には、予め設定されたタイミングに より、装置の特機時に酸素性給ライン上の電磁井10c が開いて栄素ガスに微量の極寒を混入させ、これが照明 光学系の監体および鏡筒内、さらには投影状学系の鏡筒 内に供給される。酸素の性給量は所定濃度以下(1㎡)み たり数グラム以下)になるように電磁弁の間間がコント ロールされる。この混合ガスが供給された後、電磁弁名 c、9cが間じられる。この業素ガスに微量の酸素が表 入されたガンが充填された物でレーザ外の限射を行 う。これにより、各空間に充填された不活性ガス中の酸素は光化学反応によりオブンに変換され各空間内ではじ かてオブンが発生する。この状態でさらにレー学児駅射を統付さるとしたより、光学系を構成する光学楽子(レンス、ミラー、窓など)上に付着した有機分合を修化させる。これにより光学素子上の有機分子はオブン洗冷によって絵会されたり、

【0026】この後、不活性ガス供給ライン上、及びガ ス排気ライン上の電磁弁を開き、完全に窒素ガスに顕拠 ちれるまで連絡しくは破跡的に不活性ガスの供給と排 気を続ける。これら一連の操作はコントローラに予め設 定されたプログラムに基づいで行われる。なお、光学素 テのクリーニングは露光速数が動していないが機動に 行なえばスループットに影響を与えることが築いので好ましい。また実際の装置線を動けにクリーニングを行なう よりにしてもよい。

【0027】ところで、光照射によって酸素からオゾン を生成させる効率は照射光の変長に大きく足行される。 そこで、蘇光ビーム波長を基板に蘇光を行なり時と光学 素子をクリーニングする時とで変化させ、より効率的に オゾンを発在させるようにすることが好ましい。すなわ ち、クリーニング時には波長帯域を連続的に振るように する。あるいはより短波長側に切り替えて、オゾンの生 成効率むいてはクリーニング部力を高めるようにする。 とが好ましい、波長を豪化させるには、光源の駆動を削 動するあるいは光路中に弦長変換手段(高調波発生素子 など)を挿みするなどの手定で遠成できる。

[0028] 図2は原別光学系の鏡篇2 h における、不 括性ガス性給ラインの吹き出し口近傍の拡大図である。 物に有機分子の付着が多いと予想される光学素子13 a, 13 b については、不活性ガスが光学素子に直接吹き付けられる構成としている。これによりオソン洗浄の 衆果をより一層あかている。

【0029】なお、不活性ガス供給ラインに特開平6-216000特公報等に示されるような流量の切換え手 段を設け、不純物の除去作業時には大流量の窒素を供給 するようにしても良い。

【0030】なお、露光装板の光学素子としては上述の レンズ、ミラー、窓のほかに、水銀ランプやシンクロト ロン放射線などの光額から出る広範囲の被乗締め中か ら所望の被長だけを透過するフィルタが用いられること もあるが、これについても上記同様に本発明の効果が期 付できる。

【0031】次に上記規則した解光装置を利用したデバ イ 契違方法の例を説明する。図9は微小デバイス (1 CやLS1等の学導体チップ、被温パネル、CCD、薄 酸磁気ヘッド、マイクロマシン等)の製造のフローを示 す。ステップ1 (回路設計)ではデバイスのパターン設 計を行なう。ステップ2 (マスク製作)では設計したパ ターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップ3

(ウエハ製造) ではシリコンやガラス等の材料を用いて ウエハを製造する。ステップ4(ウエハプロセス)は前 工程と呼ばれ、上記用意したマスクとウエハを用いて、 リソグラフィ技術によってウエハトに実際の回路を形成 する。次のステップ5 (組み立て) は後工程と呼ばれ、 ステップ4によって作製されたウエハを用いて半導体チ ップ化する工程であり、アッセンブリ工程(ダイシン グ、ボンディング)、パッケージング工程(チップ封 人) 等の工程を含む。ステップ6 (検査) ではステップ 5 で作製された半導体デバイスの動作確認テスト、耐久 性テスト等の検査を行なう。こうした工程を経て半導体 デバイスが完成し、これが出荷(ステップ7)される。 【0032】図10は上記ウエハプロセスの詳細なフロ ーを示す。ステップ11 (酸化) ではウエハの表面を酸 化させる。ステップ12(CVD)ではウエハ表面に絶 緑膜を形成する。ステップ13 (電極形成) ではウエハ 上に電極を蒸着によって形成する。ステップ14(イオ ン打込み)ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ1 5 (レジスト処理) ではウエハにレジストを塗布する。 ステップ16 (露光) では上記説明した露光装置によっ てマスクの回路パターンをウエハの複数のショット領域 に並べて焼付露光する。ステップ17 (現像) では露光 したウエハを現像する。ステップ18 (エッチング) で は理像1.たレジスト像以外の部分を削り取る。ステップ 19 (レジスト剥離) ではエッチングが溶んで不要とな ったレジストを取り除く。これらのステップを繰り返し 行なうことによって、ウエハ上に多重に回路パターンが 形成される。本実施例の生産方法を用いれば、従来は製 造が難しかった高精度デバイスを高い生産性で製造する ことができる。 [0033]

【発明の効果】本発明の酸光装度によれば、光学素子の 表面に有機分子が付着し限度が低下するという問題を解 表面でしたができ、この顔、露氷に使用される露氷ピー ム自体をナゾン生成にも兼用して用いているので、大き な付加機構を設けること無く実現できる。その上、オソ ン生成比火学業子が置かれる相じた空間内のかでなされ るため、有害なオゾンが外に漏れ出す危険性もない。 【0034】この魔光装置は常に高いスループットが得られるので、デバイス製造においては高い生産性が達成 できる。

#### 【図面の簡単な説明】

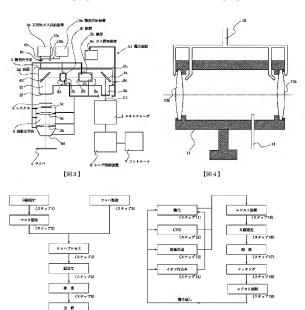
- 【図1】実施例の全体構成を説明する説明図である。
- 【図2】鏡筒内部の例を説明した図である。
- 【図3】デバイス製造方法のフローを示す図である。
  - 【図4】 ウエハプロセスの詳細なフローを示す図であ

#### 【符号の説明】

#### A1 露光装置

- 1 エキシマレーザ
- 2 昭明光学系
- 2 a ~ 2 d レンズ
- 2e,2f 窓
- 2 g 容器 2 h、2 i 鏡筒
- 2 i 容器內空間
- 3 レチクル
- 4 ウエハ
- 5 投影光学系(投影レンズ鏡筒)
- 5a、5b レンズ
- 5 c 、5 d 窓
- 6 レーザ制御装置
- 7 コントローラ
- 8 a 不活性ガス供給装置
- 8 b 不活性ガス供給ライン
- 8 c 電磁弁
- 9 a ガス排気装置
- 9 b ガス排気ライン
- 9 c 電磁弁
- 10a 酸素供給装置 10b 酸素供給ライン
- 10c 電磁弁
- 11 締笥
- 12 不活性ガス供給ライン

[図1]



フロントページの続き

(ステップで)

(51) Int. Cl. 6 機則記号 FI HO1L 21/30 516F 531A